水素終端シリコンと多価イオンとの相互作用(2)

山田千樫研究室 B4 小松 明浩

1.背景及び目的

研究室にて多価イオンと固体表面の相互 作用についての研究が行われている。その 一環として多価イオンと水素終端シリコン の相互作用の研究を行っている。そのため、 試料である水素終端シリコンを作成し、多 価イオンを照射し、ナノ領域で水素を引き 剥がす。その後、酸素を噴きつけ、ナノ酸 化膜持つ水素終端シリコンを作成す(図 1.1)。



2.多価イオンとは

一般に 2 価以上の正負のイオンを多価 イオンと言う。我々の研究室で扱っている 多価イオンは 20~80 価程度に高度に電離 したイオンである。高電離したイオンは膨 大なポテンシャルエネルギーを持つ、ヨウ 素の多価イオンの価数とエネルギーの関係 の図 2.1 を示す。図 2.1 から見て明らかな ように価数があがるにつれて、ポテンシャ ルエネルギーが膨大になっていくのが分か る。そのため、多価イオンは電子に対して ブラックホールのように振る舞い、近くか ら電子をところかまわず電子を引き抜こう とする。



3.原理

(i) 水素終端の作成法及び確認

Si(111)面に水素終端を行う。まずシリコ ンを清浄表面化する。真空度 10⁻⁹Torr 以下 でシリコン基盤を約 600℃で 15 時間通電加 熱した後、約 1000℃に数回加熱し、表面上 の酸化膜を蒸発させる。約 900℃~室温ま で毎秒 2℃未満の速度で行い清浄表面を露 出させる。

次に水素ガスを約 1500 度に加熱し原子 化させ、シリコン基盤に吹き付け、シリコ ンのダングリングボンドを水素終端させる。 また、**FT-IR**を用いて、水素終端結合に特 有な振動スペクトル(2100cm⁻¹)を観測す る。

(ii) FT-IR

(Fourier Transform InfraRed Spectroscopy)

フーリエ変換赤外分光法と呼ばれ、マイ ケルソンの干渉計を用い、干渉波を試料に 照射する。この干渉波は赤外光源で連続波 あり、また干渉計内の可動鏡による干渉の ため図 3.1 のような干渉パターンである。 試料にこの干渉波を反射させると、表面上 の原子や分子が固有の振動をするため、赤 外線吸収が起こり、対応する波長の干渉成 分が減少する。

それをコンピュータでフーリエ変換をして、 図 3.2 のような周波数の関数としての吸収 スペクトルが得られる。これにより表面原 子(分子)を同定する。





(iii)表面原子(分子)の赤外線吸収

赤外線吸収は図 3.3 のような分子振動に 伴って双極子モーメントが変化する時に起 こる。また、酸素分子や水素分子の場合、 分子間の電子密度の偏りがないため、双極 子モーメントはない、そのため分子が伸縮 振動をしても赤外線吸収は起こらない。

図 3.3 水の振動



4.測定装置及び実験方法

- ・作成した水素終端シリコンを FT-IR で水 素の分析
- ・多価イオンビームを EBIT (Electron Beam Ion Trap)を用いて試料に照射。
- ・ナノ酸化膜の作成
- FT-IR による水素終端上のナノ酸化膜
 の分析





5.測定結果及び考察

実際に作成した水素終端シリコンの FT-IR での測定を行うと図 5.1 のようなス ペクトルが見られた。左から順に、水の非 対象伸縮振動、水の伸縮振動、二酸化炭素 の非対象伸縮振動、水の偏角振動である。 このような大きな吸収が見られる原因は、 赤外光が空気中を通るためであり、試料上 の分子原子による振動のためのものでない。

また、水素終端結合に特有な振動は 2100cm⁻¹のため、その付近を拡大したのが 図 5.2 である。図 5.2 を見てみると、水素

の吸収スペクトルが出ていないように見え る、しかし、水素終端結合の吸収スペクト ルは元々非常に少ない、また、試料につい た水素の量によるため、かなり試料につい た水素が少なかった可能性がある。また、 水の偏角振動による吸収スペクトルは、水 素の吸収スペクトルより大きいため、その 中に紛れてしまった可能性がある。



そのため、水の偏角振動による吸収スペ クトルを除去する必要があり、赤外光が空 気中通る道とマイケルソンの干渉計の内部 全てをビニールで覆い、窒素ガスで満たし 同様の実験を行ったところ図 5.3 のような 結果が得られた。



図 5.3 水の偏角振動の吸収スペクトルの比較

図 5.3 から、水の偏角振動が減っているの が分かるが、これだけでは、まだ水素の吸 収スペクトルを見るに到らなかった。

6.まとめ

シリコン上で水素の振動がみられなかっ た。また、水の除去をするのに窒素ガスが 効果的であるが、それだけでは見られない ことが分かった。水の除去の他に、水素終 端の水素の付着が少ない可能性もあるため、 水素を吹き付ける角度や時間、シリコンの 加熱時間などを工夫する必要がある。

今後の展開としては水素の振動を見られる工夫をする。次に水素の吸収を確認後ナノ酸化膜を作り、ナノ酸化膜をFT-IRにて 測定を行いたい。

7. 参考文献

(i) Y.J.Chabal(Ed.)

「 Fundamental Aspects of Silicon Oxidation」

 (ii) Y.J.Chabal, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ 07974,USA
 Surface Infrared SpectroscopyJ

Surface Science Reports 8(1988)211-357

- North-Holland, Amsterdam
- (iii)日本表面科学会編
 「新訂版・表面科学の基礎と応用」
 株式会社 エヌ・ティー・エス
- (iv) 浮田宏生「電子光計測」株式会社 コロナ社